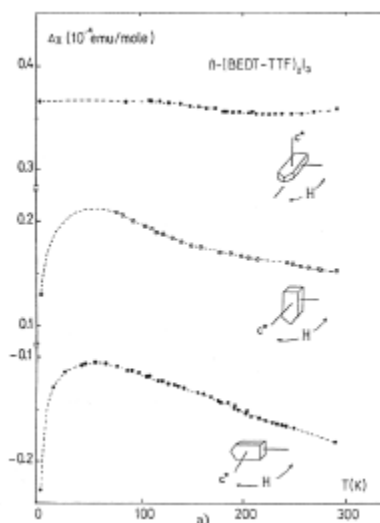
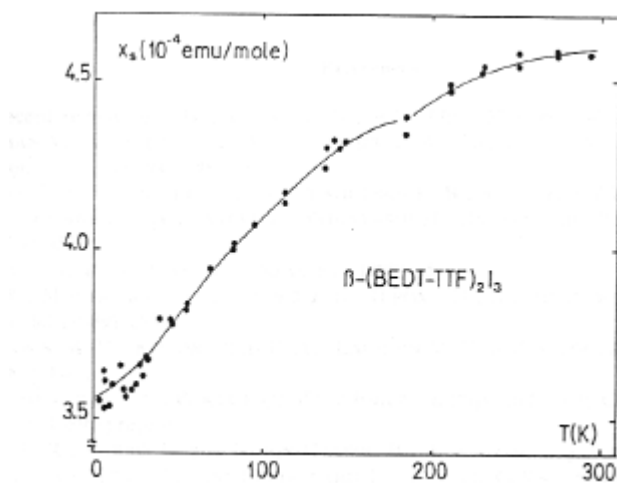


[3] β -(ET)₂X

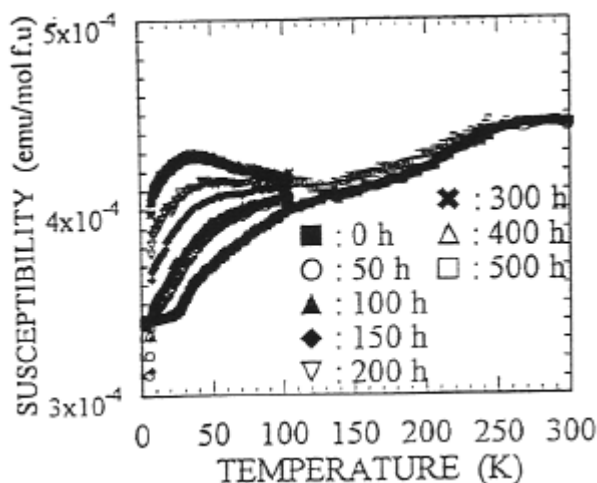
X= I₃



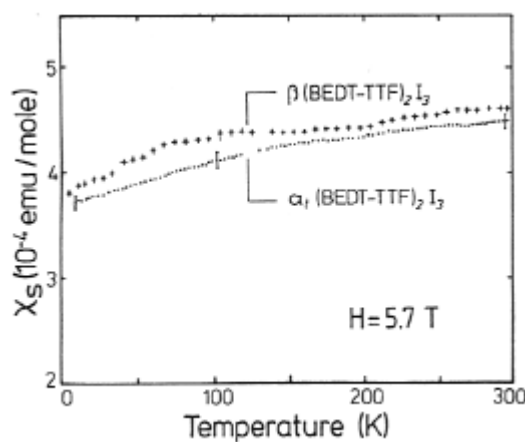
J. R. Cooper *et al.* J. Phys. France **50**, 2741 (1989)

左図コメント： 1)多結晶の静磁化率、2) コアの反磁性磁化率 -5.41×10^{-4} emu/mole を補正。

右図コメント： 1)単結晶の磁化率の異方性（挿入図中の磁場方向参照） 2) 温度に依存しない ab 面内の異方性（上のデータ）はコア反磁性の異方性からくると考察されている。



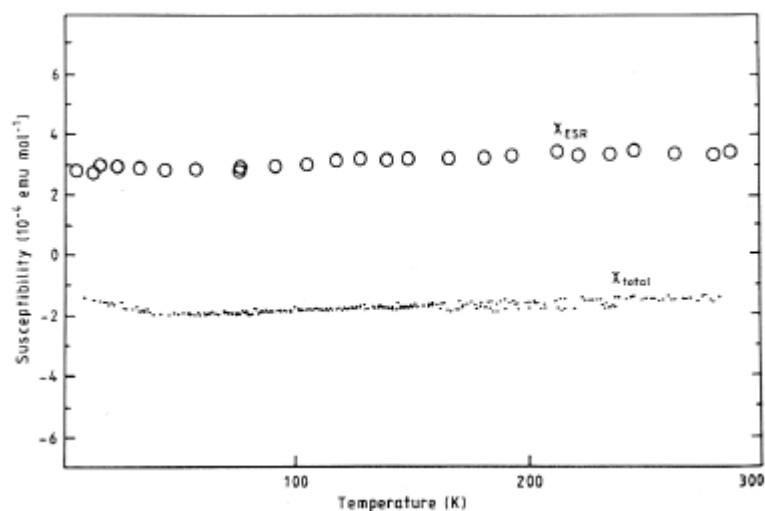
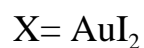
K. Miyagawa *et al.* Synth. Metals **85** 1537 (1997)



S. Klotz *et al.* Solid State Commun. **67**, 981 (1988)

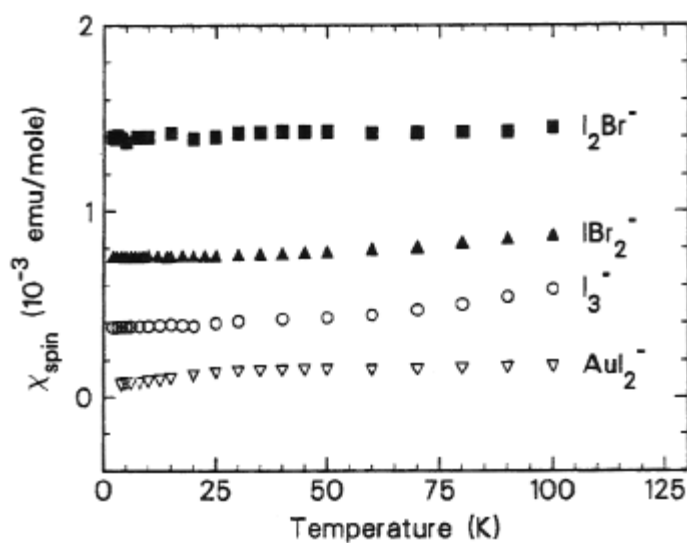
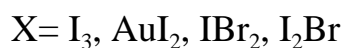
左図コメント： 1) 多結晶試料、2)静磁化率、3)104Kでアニールする時間を変えて磁化率を測定（図中の数字がアニール時間） 4)0hのデータ（下）が β_L 相、500hのデータ(上)が β_H 相に対応すると考えられている、5) コアの反磁性磁化率を -5.17×10^{-4} emu/mole として補正。

右図コメント： 1) α_L -(ET)₂I₃とは、 α -(ET)₂I₃を摂氏 70 度で約 4 日間アニールしたものを言い、超伝導特性や構造が β_H -(ET)₂I₃と似ている、2)多結晶試料による測定、3)静磁化率、4) コアの反磁性を -5.2×10^{-4} emu/mole として補正。



D. R. Talham et al., J. Phys. C, 19, L383 (1986)

- コメント： 1) χ_{total} (●) が多結晶試料の静磁化率、コアの反磁性磁化率を -5.2×10^{-4} emu/mole として補正。
 2) χ_{ESR} (○) が単結晶の ESR で求めたスピン磁化率。



E. L. Venturini et al. Synth. Met. **27**, 243 (1988)

- コメント： 1) 単結晶の ESR で求めたスピン磁化率。